

稀産金属於10年前開始開發不純物質最小極限之結晶育成用氧化鎵



外觀照



粒子照

次世代半導體材料

氧化鎵 Ga_2O_3

稀産金属致力於開發純度最佳的氧化鎵

純度：99.99% Si 含量 5ppm以下

99.999% Si 含量 3ppm以下

應用：燒結用，結晶生成等

| 項目 | 規格 |
|-----------------|----------|
| 銅 (Cu) ppm | ≤ 1.0 |
| 鉄 (Fe) ppm | ≤ 2.5 |
| カルシウム (Ca) ppm | ≤ 2.5 |
| アルミニウム (Al) ppm | ≤ 2.5 |
| マグネシウム (Mg) ppm | ≤ 1.5 |
| 純度 % | ≥ 99.999 |



外觀照

最佳半導體靶材

氧化銦 In_2O_3

稀産金属除了提供純度99.99%氧化銦化合物外，

同時也提供如：氯化銦、硝酸銦、氫氧化銦

| No. | 規格項目 | 單位 | 規格值 | 備考 |
|------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| ○ 1 | 硝酸塩 (NO ₃) | % | ≤ 0.005 | JIS K8001 |
| ○ 2 | 鉛 (Pb) | % | ≤ 0.0005 | ICP-AES |
| ○ 3 | 銅 (Cu) | % | ≤ 0.0005 | ICP-AES |
| ○ 4 | 鉄 (Fe) | % | ≤ 0.0005 | ICP-AES |
| ○ 5 | 亜鉛 (Zn) | % | ≤ 0.0005 | ICP-AES |
| ○ 6 | カドミウム (Cd) | % | ≤ 0.0005 | ICP-AES |
| ○ 7 | ケイ素 (Si) | % | ≤ 0.001 | ICP-AES |
| ○ 8 | 錫 (Sn) | % | ≤ 0.0005 | ICP-AES |
| ○ 9 | マグネシウム (Mg) | % | ≤ 0.0005 | ICP-AES |
| ○ 10 | 純度 | % | ≥ 99.99 | 上記不純物の差数法 |
| ○ 11 | 比表面積 | m ² /g | 10.0 ~ 12.0 | 比表面積計 (BET) |
| ○ 12 | 粒度分布 (d ₅₀) | μ m | ≤ 1.0μm | レーザー回折式粒度分布計 |

更多詳細原料供應，請見：

◆ 台灣岩谷



台灣岩谷股份有限公司 <https://www.iwatani.com.tw/ja-jp/about>

電話：02-2506-6955 傳真：02-2507-2789 郵箱：service@iwatani.com.tw

◆ 稀産金属



稀産金属株式會社 <https://www.kisankinzoku.co.jp/>

電話：+81-06-6473-5227